

锑化铟 (InSb) 晶圆规格		
晶体生长方法	VGF	
类型/掺杂剂	Undoped // N/S/Sn // P/Zn	
直径(mm)	50.8±0.3	76.2±0.3
厚度(um)	500±25	650±25
主定位边长度(mm)	16±2	22±2
副定位边长度(mm)	8±2	12±2
晶向	<100>	
TTV(um)	≤10	≤15
Bow(um)	≤15	≤15
Wrap(um)	≤15	≤15
表面状态	抛光/蚀刻	
外延就绪	Yes	